о5 Влияние атомов меди на структуру графита

© В.Д. Андреева, Т.Р. Степанова

С.-Петербургский государственный технический университет E-mail: szss@ctinet.ru

Поступило в Редакцию 15 апреля 2002 г.

Показано экспериментально, что внедренные атомы меди приводят к изменению электронной плотности, а следовательно, и структуры плоскостей графита. Предложенная методика позволяет из эксперимента вычислить функцию, описывающую искажения структуры, и определить смещение атомов в искаженных плоскостях.

Интерес к материалам на основе углерода вызван широкими возможностями в изменении их свойств. Динамичность структур, образуемых атомами углерода, позволяет управлять их физическими свойствами в достаточно широком диапазоне. В данной работе исследовался графит с введенными в него атомами меди. Термодинамическая стабильность графита обусловлена не столько наличием $sp^2(s, p_z, p_y)$ -гибридизированных орбиталей у атомов углерода, сколько делокализацией p_z -электронов, орбитали которых перпендикулярны плоскостям молекулярных сеток и в результате $\sigma - \pi$ -сопряжения образуют единую электронную систему. В противном случае основной термодинамически устойчивой формой углерода в природе был бы алмаз.

Среди всех изоэлектронных аналогов углерода только нитрид бора имеет более устойчивую гексагональную слоистую структуру. Остальные соединения (такие как BeO, AlN, AlP, BP, BAs и др.) существуют в виде плотных форм с sp^3 -гибридизированными орбиталями у атомов. Переходные металлы, имеющие недостроенные *d*-электронные оболочки, могут вызвать снижение делокализации p_z -электронов в молекулярных слоях графита. При внедрении атомов металла в пространство между сетками графита происходит перекрывание *d*-орбиталей металла с π -орбиталями графита, что снижает делокализацию электронов в направлении молекулярных сеток. Между металлом и графитом могут образовываться не только достаточно сильные связи

18

Nº 1		Nº 2			
$ heta_{ m max}$	<i>I</i> , a.u.	$ heta_{ m max}$	<i>I</i> , a.u.	d, nm	hkl
_		$pprox 7^\circ 42'$	0.3	0.7	001
$16^{\circ}48'$	100	∫16°48′	97	0.336	002
-		$pprox 26^\circ 12'$	0.2	0.2	003
35°12′	6	∫35°12′	100	0.168	004
		\35°24'			
59° 54′	1	∫ 59° 54′	73	0.112	006
		∫60°6′			

Рентгенограмма графита (HOPG) — образец N
е1и графита с медью — образец N
е2

с участием *d*-электронов металла, но и слабые ван-дер-ваальсовы. От их соотношения зависит степень разрушения делокализованной системы электронов графита. Незначительные добавки этих металлов приводят не только к изменению приводящих свойств графита, но и к уменьшению термодинамических параметров (температуры и давления) фазового превращения графита в алмаз [1]. Поэтому большой интерес представляет влияние атомов переходных металлов на структуру графита. Медь была выбрана из-за того, что она не образует карбидов.

Результаты эксперимента. Исследования производились на дифрактометре ДРОН-2.0 с использованием монохроматизированного Fe_{Ka}-излучения.

В качестве образцов использовался высокоориентированный пиролитический графит (HOPG), интеркалированный медью. Интеркалирование медью образцов графита осуществлялось их двадцатиминутной выдержкой в расплаве меди чистотой 9.99% при температуре 1473 К в вакууме.

Как видно из экспериментальных данных, приведенных в таблице, рентгенограмма исходного образца (N $_{0}$ 1) соответствует монокристаллическому гексагональному графиту с параметром решетки $c_{0} = 0.672$ nm. Отражения (002), (004) и (006) имеют интенсивности,

соответствующие эталонным. На дифрактограмме образца № 2 (с медью) линии, соответствующие гексагональной структуре, раздвоились и к ним добавились два размытых (диффузных) рефлекса.

Рассмотрим влияние на дифракционную картину искажений в гексагональной структуре, которая может быть описана как множество плоскостей (слоев) [2]. Предположим, что положение слоев в дефектной структуре не отличается от идеальной, однако в некоторых плоскостях происходит смещение атомов вдоль вектора с. Каждая из плоскостей, отстоящая на расстоянии $R_u = uc_0$ от начала отсчета, даст амплитуду

$$A_u(\mathbf{h}) = E_{\Im}F_u(\mathbf{h})\exp\left(-i\frac{2\pi}{\lambda}\mathbf{h}\cdot\mathbf{R}_u\right)$$

Структурная амплитуда $F_u(\mathbf{h})$ будет теперь изменяться от слоя к слою в соответствии с конкретным расположением атомов в слое с координатами *и*. Тогда выражение для итенсивности, рассеянной кристаллом, содержащим *N* слоев, будет

$$I(\mathbf{h}) = \sum_{\{u\}} \sum_{u'} A_u(\mathbf{h}) A_{u'}^*(\mathbf{h})$$

= $I_3 \sum_{n=-\infty}^{\infty} (N - |n|) \langle F_{n+n'} F_{u'}^* \rangle \exp\left(-i \frac{2\pi}{\lambda} \mathbf{h} \cdot_n \mathbf{R}\right).$ (1)

Текущее значение структурной амплитуды F_u можно представить как сумму среднего значения $\langle F \rangle$ и флуктуации ΔF_u :

$$F_u = \langle F \rangle + \Delta F_u.$$

Учитывая, что $\langle \Delta F \rangle = 0$, получим

$$\langle F_{n+u'} \cdot F_{u'}^* \rangle = |\langle F \rangle|^2 + \Phi^{\Delta}(n, \mathbf{h}),$$

где $\Phi^{\Delta}(n, \mathbf{h}) = \langle \Delta F_{n+u'} \Delta F_{u'}^* \rangle$ является средним значением функции автокорреляции флуктуаций структурной амплитуды.

Теперь выражение (1) можно записать в виде

$$I(\mathbf{h}) = I_{\mathfrak{I}} |\langle F \rangle|^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(N - |n| \right) \exp\left(-i \frac{2\pi}{\lambda} \mathbf{h} \cdot_n \mathbf{R} \right)$$
$$+ I_{\mathfrak{I}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(N - |n| \right) \Phi^{\Delta}(n, \mathbf{h}) \exp\left(-i \frac{2\pi}{\lambda} \mathbf{h} \cdot_n \mathbf{R} \right)$$

Первое слагаемое

$$I_1(\mathbf{h}) = I_9 |\langle F \rangle|^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} (N - |n|) \exp\left(-i \frac{2\pi}{\lambda} \mathbf{h} \cdot_n \mathbf{R}\right)$$

описывает обычную брэгговскую дифракционную картину. Второе слагаемое

$$I_{2}(\mathbf{h}) = I_{3} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(N - |n| \right) \Phi^{\Delta}(n, \mathbf{h}) \exp\left(-i \frac{2\pi}{\lambda} \mathbf{h} \cdot_{n} \mathbf{R} \right)$$

непосредственно описывает влияние флуктуаций положения атомов в слое. Вид функции I_2 будет целиком определяться Фурьепреобразованием функции $\Phi^{\Delta}(n)$. (Фурье-преобразование $\hat{F}[N-|n|]$ дает обычный формфактор).

Если в чередовании слоев *ABAB*, характерных для гексагонального графита, появляется дефектный слой A', который замещает какую-то часть слоев *A*, то флуктуация ΔF будет зависеть от координаты плоскости *u*. Так как расстояние *AA'* является постоянной величиной, то это приведет к появлению фазового множителя, т. е. функция

$$\Phi^{\Delta}(n) = \Phi_0^{\Delta} \exp\left(-i \frac{2\pi}{\lambda} {}_{\Delta} \mathbf{h} \cdot \mathbf{R}_n\right),$$

а ее Фурье-преобразование

$$\hat{F}\left[\Phi_0^{\Delta}\exp\left(-i\frac{2\pi}{\lambda}\,_{\Delta}\mathbf{h}\cdot_n\mathbf{R}\right)\right]=\Phi_0^{\Delta}\delta(\mathbf{h}+_{\Delta}\mathbf{h}).$$

Это то самое появление второго максимума рядом с брэгговским, которое мы наблюдаем в эксперименте (см. таблицу). В этом случае параметр решетки не меняется, т.е. плоскости остаются на своих местах, параметр $c_0 = 0.672$ nm, а происходят изменения в самих слоях.

Фазовый множитель приводит к еще одной особенности в дифракционной картине — появлению диффузных максимумов, имеющих нечетные l ((001) и (003)). Известно, что в гексагональной решетке графита из-за симметрии, содержащей винтовую ось шестого порядка, отражения от атомов соседних плоскостей имеют разность фаз, равную πl , потому из всех индексов дифракции (00l), соответствующих



Смещение атомов при "гофрировке" плоскостей графита. Два способа расщепления слоев в графите (*a* и *b*); вверху показаны исходные слои и направление смещений атомов при сдвиговой деформации, внизу — атомные конфигурации после расщепления и положения плотоупакованных плоскостей в тетраэдрических структурах.

рассматриваемой структуре, сохраняются только те, у которых l — четное. Изменение разности фаз приводит, в свою очередь, к появлению слабых рефлексов, не характерных для гексагональной структуры.

Анализ дифракционной картины графита, содержащего атомы меди, показывает, что в структуре графита появляются плоскости, атомы в которых смещены из исходных положений, как показано на рисунке. Возможны два варианта смещения [3], но поскольку мы пока не можем их определить, называя плоскости "гофрированными", мы подразумеваем любой из возможных вариантов. Атомам металла энергетически не выгодно занимать пространство по обеим сторонам одной и той же сетки графита, поэтому дефектные плоскости чередуются с нормальными. Относительное число подобных плоскостей может быть оценено из экспериментальных данных — около 5%.

Таким образом, атомы меди образуют в графите промежуточный комплекс, при этом хотя двумерные сетки графита и сохраняются, но имеют менее устойчивую делокализованную систму электронов по сравнению с чистым графитом. Атом металла может мигрировать от одной пары колец графита к другой. В результате такого перехода освободившиеся p_z -электроны углерода образуют с *s*-, p_x -, p_y -электронами уже sp^3 -орбитали, а не π -связи. Т.е. как только атом металла покинет пару колец в плоскости сетки графита, в последней мгновенно устанавливаются "алмазные" связи с одновременной гофрировкой молекулярных сеток в том месте, где был металл.

Выводы. Приведены данные рентгеноструктурного анализа, указывающие на изменение структуры графита, содержащего атомы меди. И хотя гексагональная структура графита "в среднем" сохраняется, в ней появляются плоскости со смещенными атомами ("гофрированные" плоскости). Относительное смещение атомов в искаженных плоскостях вдоль оси *с* составляет 15 ± 5 pm. Такие гофрированные плоскости появляются из-за того, что атом меди вызывает изменение электронной плотности в молекулярных сетках, в результате чего освободившиеся p_z -электроны углерода образуют с *s*-, p_x -, p_y -электронами уже *sp*³-орбитали, а не π -связи.

Список литературы

- [1] Фарафонтов В.И., Калашников Я.А. // ЖФХ. 1976. № 4. С. 830–837.
- [2] Васильев Д.М. Дифракционные методы исследования структур. М.: Изд-во СПБГТУ, 1998. 502 с.
- [3] Полиморфные модификации углерода и нитрида бора / Курдюмов А.В., Пилянкевич А.Н. М.: Металлургия, 1994. 318 с.